

Silicon PIN Diode

BA679S

30V / 50mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 679 · BA 679 S

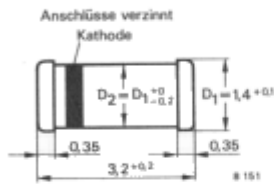
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:

- Großer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55 ... + 125	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	$R_{th,JA}$	500	K/W
--	-------------	-----	-----

Kenngrößen

$T_{amb} = 25$ °C, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung				1	V
$I_F = 20$ mA	U_F				
Sperrstrom				50	nA
$U_R = 30$ V	I_R				
Diodenkapazität				0,5	pF
$U_R = 0, f = 100$ MHz	C_D				
Differentieller Durchlaßwiderstand				50	Ω
$I_F = 1,5$ mA, $f = 100$ MHz	r_f				
Sperrimpedanz					
$U_R = 0, f = 100$ MHz	z_r		5		kΩ
				9	kΩ
	BA 679				
	BA 679 S				

BA 679 · BA 679 S

